



⑪ Numéro de publication : **0 526 344 A1**

⑫

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

⑳ Numéro de dépôt : **92402203.1**

⑤① Int. Cl.⁵ : **C03C 17/245, C03C 17/00, C23C 16/40, C23C 16/44**

㉔ Date de dépôt : **31.07.92**

㉓ Priorité : **31.07.91 FR 9109717**

④③ Date de publication de la demande :
03.02.93 Bulletin 93/05

⑥④ Etats contractants désignés :
BE DE ES FR GB IT LU NL SE

⑦① Demandeur : **L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE**
75, Quai d'Orsay
F-75007 Paris (FR)

⑦② Inventeur : **Dick, Sami**
1 square Raphael
F-78150 Le Chesnay (FR)
Inventeur : **Genies, Bernard**
53 avenue de Beauséjour
F-91440 Bures sur Yvette (FR)
Inventeur : **Ougarane, Lahcen**
1 rue Jean Cocteau
F-78180 Montigny le Bretonneux (FR)
Inventeur : **Recourt, Patrick**
5 rue Toulouse-Lautrec
F-91460 Marcoussis (FR)

⑦④ Mandataire : **Le Moenner, Gabriel et al**
L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude
75, Quai d'Orsay
F-75321 Paris Cédex 07 (FR)

⑤④ Procédé de formation d'un dépôt comprenant de la silice sur une surface d'un objet en verre.

⑤⑦ On forme un dépôt d'une couche à base de silice sur une surface d'un objet en verre (1) en projetant sur une surface chaude de l'objet, en atmosphère ambiante non confinée, un mélange gazeux ayant une teneur en silane inférieure à 2 %, une teneur en oxygène comprise entre 3,5 et 30 %, et avantageusement une teneur en hydrogène inférieure à 5 %. La surface de l'objet à traiter est avantageusement chauffée (6) juste avant son passage au poste d'injection.

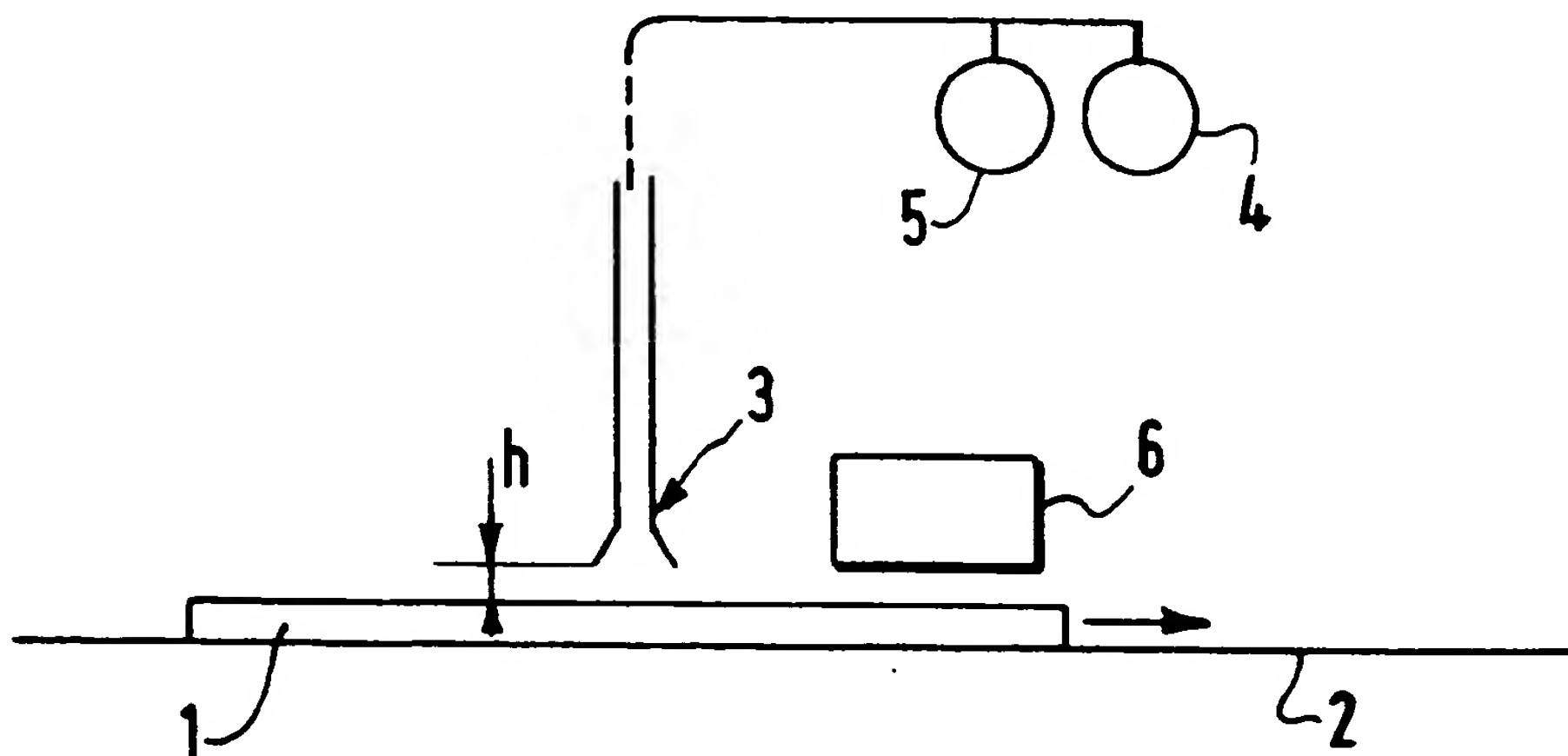


FIG.1

EP 0 526 344 A1

La présente invention concerne les procédés de formation d'un dépôt comprenant de la silice sur une surface d'un objet en verre par projection d'un mélange gazeux comprenant un gaz neutre majoritaire, un précurseur du silicium et de l'oxygène sur la surface chaude de l'objet au moyen d'au moins une buse de projection.

Un procédé de ce type est connu du document US-A-3.717.498 où la projection est effectuée de façon confinée dans un tube. Plus récemment, le document GB-A-2.234.264 décrit un procédé similaire, pour du verre plat, où l'injection s'effectue dans une chambre de revêtement recouvrant la zone à revêtir et elle-même enclose dans une hotte aspirante munie de jupes d'étanchéité.

La présente invention a pour objet de proposer un procédé du type ci-dessus, convenant notamment pour la formation sur la surface d'un objet en verre, notamment sodo-calcique ou fluorosilicate, de couches barrières anti-migration, en particulier de sodium sur les verres sodo-calciques, et pour l'augmentation de la résistance de l'objet en verre aux milieux alcalins, notamment aux produits détergents, permettant d'effectuer de façon simple et particulièrement souple des dépôts de qualité sur un grand nombre d'objets en verre, et autorisant de ce fait des coûts d'installation et de production notablement réduits.

Pour ce faire, selon une caractéristique de l'invention, la projection est effectuée sur la surface chaude de l'objet en verre en atmosphère ambiante non confinée, typiquement à l'air libre.

Selon une caractéristique plus particulière de l'invention, la teneur en précurseur du silicium, typiquement un silane, dans le mélange gazeux est comprise entre 0,5 et 2 %, typiquement d'environ 1 %, la teneur en oxygène dans le mélange gazeux étant comprise entre 3,5 et 30 %, typiquement entre 7 et 15 %.

Selon une autre caractéristique de l'invention, on adjoint au mélange gazeux à projeter de l'hydrogène, à une teneur typiquement inférieure à 5 %.

Selon des caractéristiques plus particulières de l'invention, la teneur en hydrogène dans le mélange gazeux est comprise entre 0,1 et 5 %, typiquement supérieure à 2 % et avantageusement d'environ 3 %, la teneur en précurseur du silicium, typiquement un silane, avantageusement le monosilane, étant comprise entre 0,1 et 2 %, avantageusement d'environ 1 %, la teneur en oxygène dans le mélange gazeux étant comprise entre 3,5 et 30 %, le rapport volumique entre l'oxygène et le précurseur de silicium étant de préférence compris entre 5 et 20, typiquement supérieur à 7, le rapport volumique entre l'hydrogène et le silane étant de préférence supérieur à 2, typiquement d'environ 3.

Selon une autre caractéristique de l'invention, la surface de verre à traiter est chauffée sélectivement juste avant la projection du mélange gazeux, à l'air libre, sur la surface chauffée.

La Demanderesse a constaté que, de façon surprenante, dans les conditions sus-mentionnées, par la projection à l'air libre du mélange gazeux sur la surface de verre chaude (à une température comprise entre environ 300° et la température de formage du verre), on obtenait le dépôt d'une couche homogène, uniforme, non granulaire et stoechiométrique de silice ou de silice hydrogénée sans qu'il y ait de redéposition notable sur cette couche de particules isolées contenant de la silice.

La présente invention sera mieux comprise au vu de la description suivante de modes de réalisation, donnée à titre illustratif mais nullement limitatif, faite en relation avec les dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique d'un premier mode de réalisation d'une installation pour la mise en oeuvre du procédé selon l'invention ; et
- les figures 2 et 3 sont des vues schématiques d'autres modes de réalisation de l'invention.

On a représenté schématiquement sur la figure 1 une plaque de verre 1 acheminée à l'air libre sur une bande transporteuse 2 sur le trajet de laquelle est disposée une buse 3 de projection d'un mélange ternaire silane-oxygène-azote pour la formation, sur la surface supérieure de la plaque 1, d'une couche de silice. Dans ce mode de réalisation, la buse 3 définit une fente de projection transversale à la direction d'avancement relatif de la plaque 1 et est alimentée en mélange ternaire à partir d'un réservoir 4 contenant un mélange binaire d'azote et de silane et d'un réservoir 5 d'oxygène gazeux. La buse de projection 3 peut être disposée directement en aval d'un four de flottage d'où la plaque de verre 1 sort à la température requise. Le poste de projection peut être toutefois prévu indépendamment de tout four, auquel cas, typiquement, un poste de chauffe 6, par exemple à infrarouges, sera disposé juste en amont du poste de projection dans le sens de défilement de la plaque 1.

Dans ce mode de réalisation, la distance h entre l'extrémité de la buse 3 et la surface à revêtir de la plaque 1 est inférieure à 15 mm, et comprise typiquement entre 3 et 10 mm, la vitesse d'éjection du mélange étant comprise entre 5 et 30 m/seconde, selon la largeur de la fente.

La teneur en silane dans le mélange gazeux est comprise entre 0,5 et 2 %, de préférence entre 0,8 et 1 %, la teneur en oxygène dans le mélange gazeux étant comprise entre 3,5 et 30 %, de préférence entre 7 et 15 %, le rapport volumique oxygène/silane étant compris entre 5 et 30, typiquement entre 7 et 15, de préférence entre 7 et 10.

Dans ces conditions, avec une vitesse de défilement relative entre la plaque et la buse de 5 cm/seconde et un nombre de passages successifs correspondant à un temps d'injection réel sur une zone élémentaire de

5

10

20

25

30

40

- 45

50

55

On a représenté sur la figure 2 l'application du procédé au revêtement de la surface interne d'une soucoupe

ou d'une assiette 1' sortant d'un four de réchauffe 60. Dans ce mode de réalisation, la buse d'injection 3' est conformée à la façon d'un tore comportant une fente d'injection circulaire 30 de diamètre adapté à celui de la soucoupe 1', la buse 3' étant abaissée au-dessus de la soucoupe 1' à sa sortie du four 60, de formage ou de réchauffe, et accompagnant le déplacement de cette dernière pendant une durée comprise entre 3 et 20 secondes, selon l'épaisseur de couche de dépôt désirée. La buse peut également présenter une surface d'éjection poreuse de dimension et de forme correspondant étroitement à celles de l'objet à traiter. Les mêmes mélanges gazeux que précédemment sont utilisés.

Dans le mode de réalisation de la figure 3, l'objet en verre à revêtir est ici constitué d'un flacon 1" qui, encore chaud, est placé sur un support tournant 20. Une première buse cylindrique 3"₁ est introduite dans le col du flacon 1" tandis qu'une seconde buse 3"₂ présentant une fente d'éjection parallèle à une génératrice du flacon 1" est disposée au voisinage de la paroi externe de ce dernier. Les mêmes mélanges gazeux que précédemment sont éjectés par les deux buses 3"₁ et 3"₂, le temps d'injection à l'intérieur du flacon étant compris entre 3 et 5 secondes, ce qui permet une intégration aisée dans une chaîne de production industrielle.

Quoique la présente invention ait été décrite en relation avec des modes de réalisation particuliers, elle ne s'en trouve pas limitée pour autant mais est au contraire susceptible de modifications et de variantes qui apparaîtront à l'homme de l'art.

Revendications

1. Procédé de formation d'un dépôt de silice sur une surface d'un objet en verre (1, 1', 1") par projection d'un mélange gazeux comprenant un gaz neutre majoritaire, un précurseur du silicium et de l'oxygène sur la surface chaude de l'objet en verre au moyen d'au moins une buse de projection (3; 3'; 3"₁, 3"₂), caractérisé en ce que la projection est effectuée sur la surface chaude en atmosphère ambiante non confinée.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on chauffe sélectivement (6) au moins la surface à traiter de l'objet en verre juste avant la projection du mélange gazeux.
3. Procédé selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que la buse (3; 3'; 3"₁, 3"₂) est animée d'un mouvement relatif par rapport à la surface à traiter.
4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la buse comporte au moins un orifice d'éjection adapté à la géométrie de la surface à traiter.
5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la distance (h) entre la buse (3; 3'; 3"₂) et la surface à traiter est inférieure à 15 mm.
6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que la distance (h) est comprise entre 3 et 10 mm.
7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la vitesse d'éjection du mélange est comprise entre 5 et 30 m/s.
8. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le précurseur du silicium est un silane dont la teneur dans le mélange gazeux est comprise entre 0,5 et 2 % environ.
9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que la teneur en silane est d'environ 1 %.
10. Procédé selon l'une des revendications 8 ou 9, caractérisé en ce que la teneur en oxygène dans le mélange gazeux est comprise entre 3,5 et 30 % environ.
11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que la teneur en oxygène est comprise entre 7 et 15 % environ.
12. Procédé selon l'une des revendications 9 à 11, caractérisé en ce que le rapport volumique entre l'oxygène et le silane dans le mélange gazeux est d'environ 7.
13. Procédé selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comporte l'étape d'adjoindre de l'hydrogène au mélange gazeux à projeter.
14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce que la teneur en hydrogène dans le mélange gazeux

est comprise entre 0,1 et 5 %.

- 5
15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en ce que la teneur en précurseur du silicium dans le mélange gazeux est comprise entre 0,1 % et 2 % environ.
- 10
16. Procédé selon la revendication 15, caractérisé en ce que la teneur en oxygène dans le mélange gazeux est comprise entre 3,5 et 30 % environ.
17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce que le rapport volumique, dans le mélange gazeux, entre l'oxygène et le précurseur du silicium est compris entre 5 et 20.
18. Procédé selon la revendication 17, caractérisé en ce que le précurseur du silicium est un silane.
19. Procédé selon la revendication 18, caractérisé en ce que la teneur en silane dans le mélange gazeux est d'environ 1 %.
- 15
20. Procédé selon la revendication 19, caractérisé en ce que le rapport volumique, dans le mélange gazeux, entre l'hydrogène et le silane est supérieur à 2.
21. Procédé selon la revendication 19 ou la revendication 20, caractérisé en ce que le rapport volumique, dans le mélange gazeux, entre l'oxygène et le silane est supérieur à 7.
- 20
22. Procédé selon l'une des revendications 19 à 21, caractérisé en ce que la teneur en hydrogène dans le mélange gazeux est d'environ 3 %.
23. Procédé selon l'une des revendications 13 à 22, caractérisé en ce que la température du mélange gazeux est maintenue inférieure à 200°C jusqu'à son éjection.
- 25
24. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le mélange gazeux est projeté sur la surface de l'objet en verre pendant au moins 2 secondes.
- 30
25. Procédé selon la revendication 24, caractérisé en ce que le mélange gazeux est projeté sur la surface pendant une durée comprise entre environ 5 et 20 secondes.
26. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le gaz neutre est l'azote.
- 35
27. Procédé selon l'une des revendications 1 à 25, caractérisé en ce que le gaz neutre est l'argon.

40

45

50

55

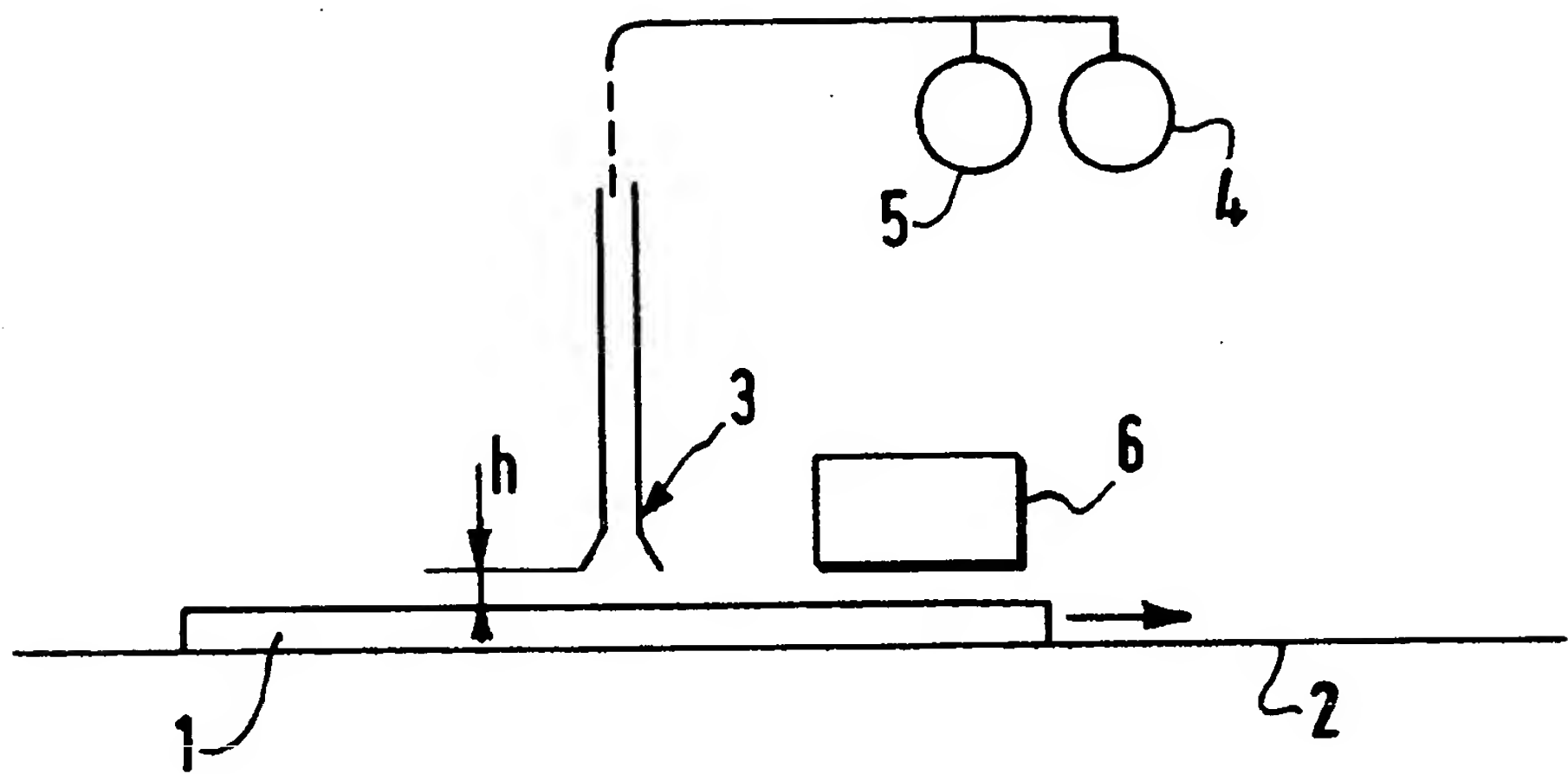


FIG. 1

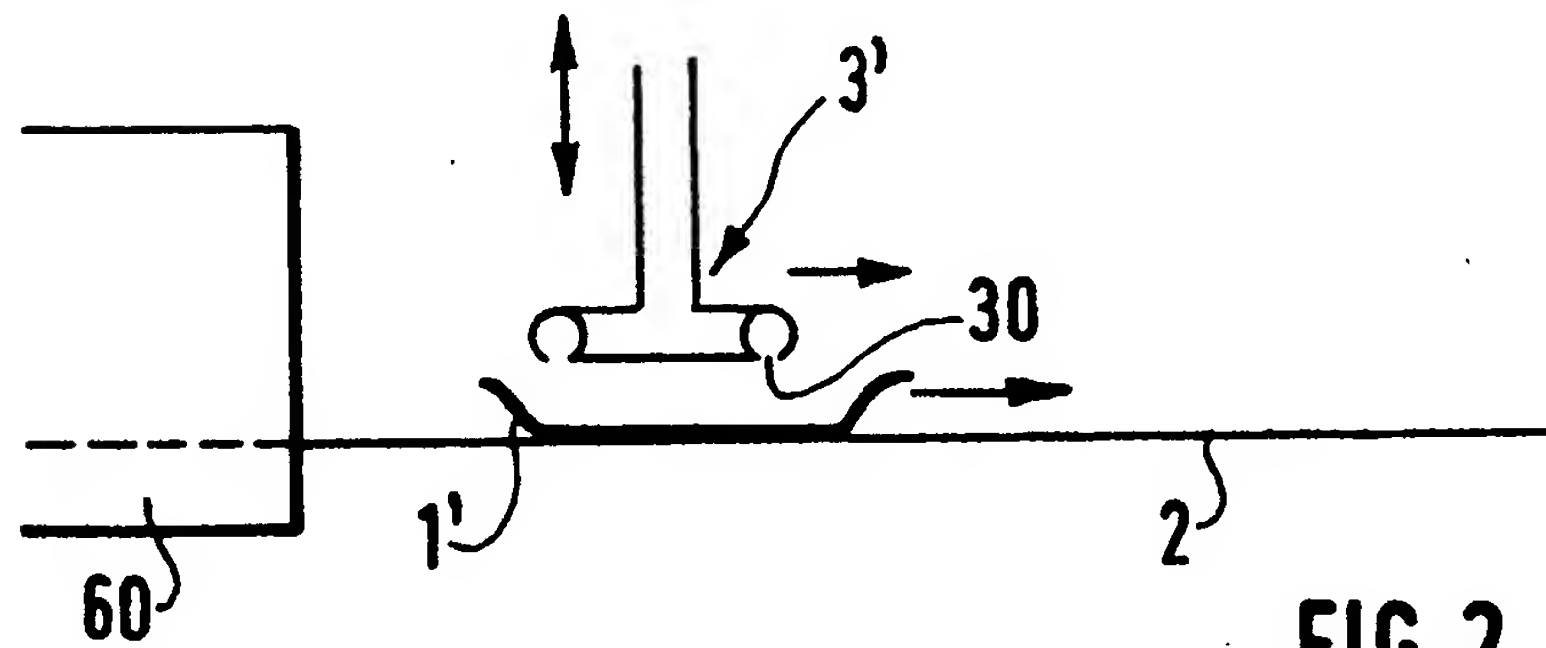


FIG. 2

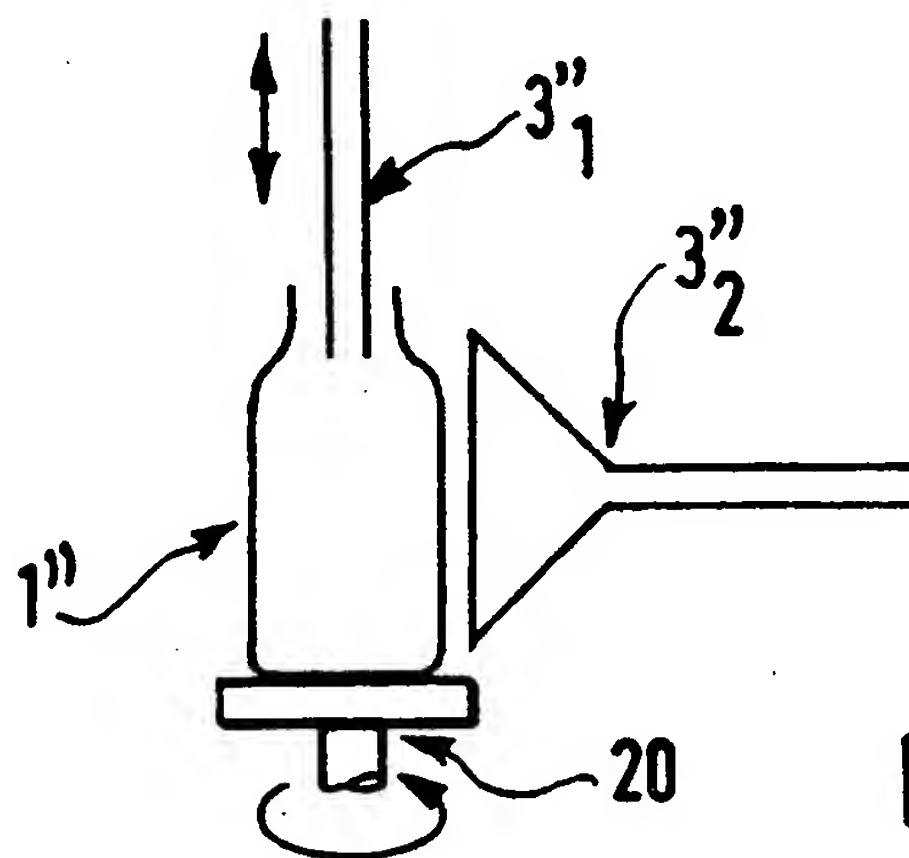


FIG. 3



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 92 40 2203

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
A	EP-A-0 213 045 (SAINT-GOBAIN VITRAGE) * page 4, ligne 18 - page 6, ligne 30; revendications *	1-27	C03C17/245 C03C17/00 C23C16/40 C23C16/44
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2, no. 93 (C-19)29 Juillet 1978 & JP-A-53 054 181 (FUJITSU K.K.) 17 Mai 1978 * abrégé *	1	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 384 (C-629)(3732) 24 Août 1989 & JP-A-1 132 769 (NEC CORP.) 25 Mai 1989 * abrégé *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
			C03C C23C C04B
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 27 OCTOBRE 1992	Examinateur VAN BOMMEL L.
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 03.92 (P0403)

THIS PAGE BLANK (USPTO)